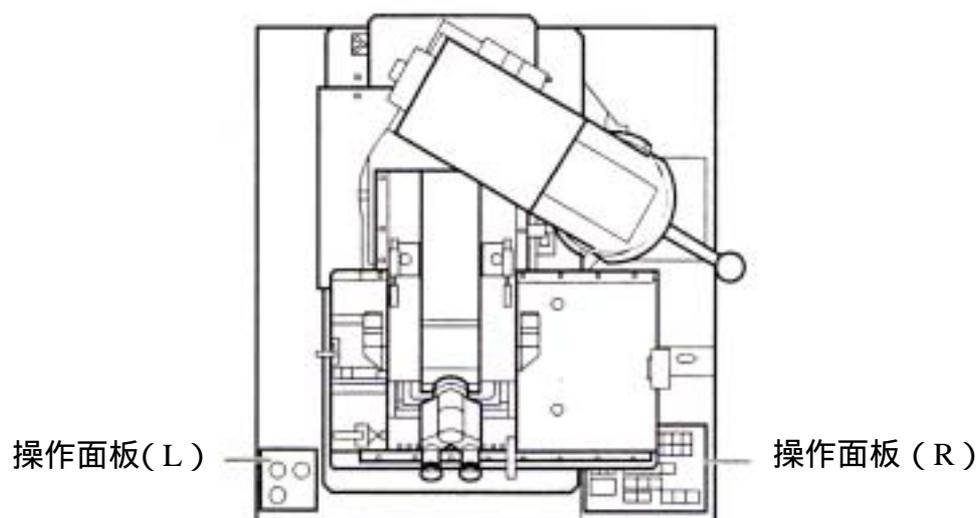
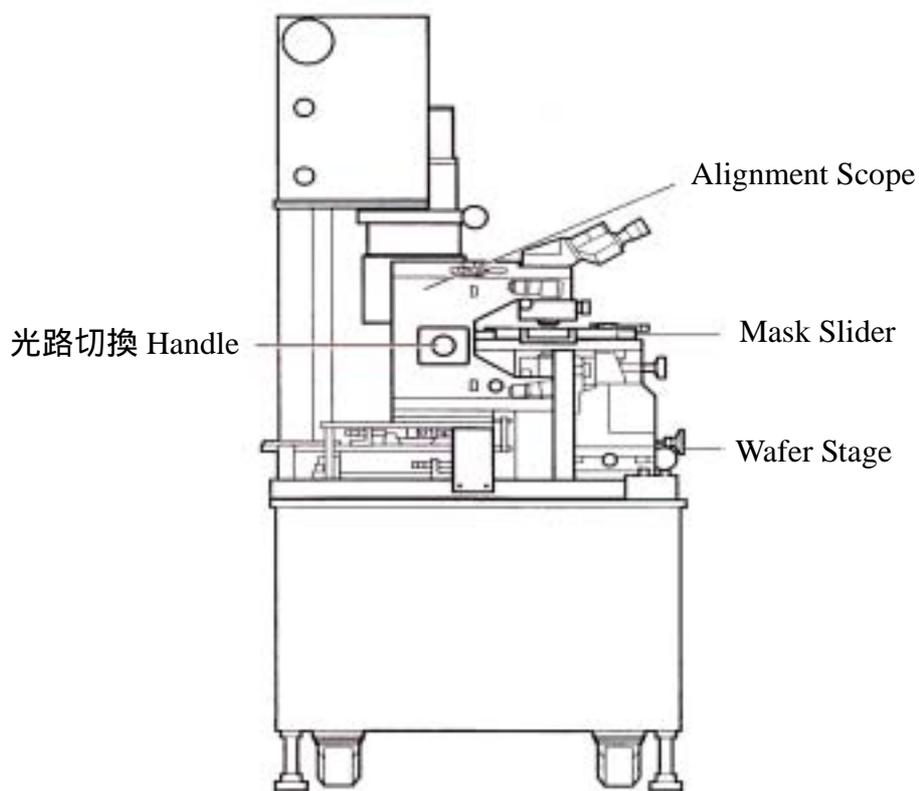
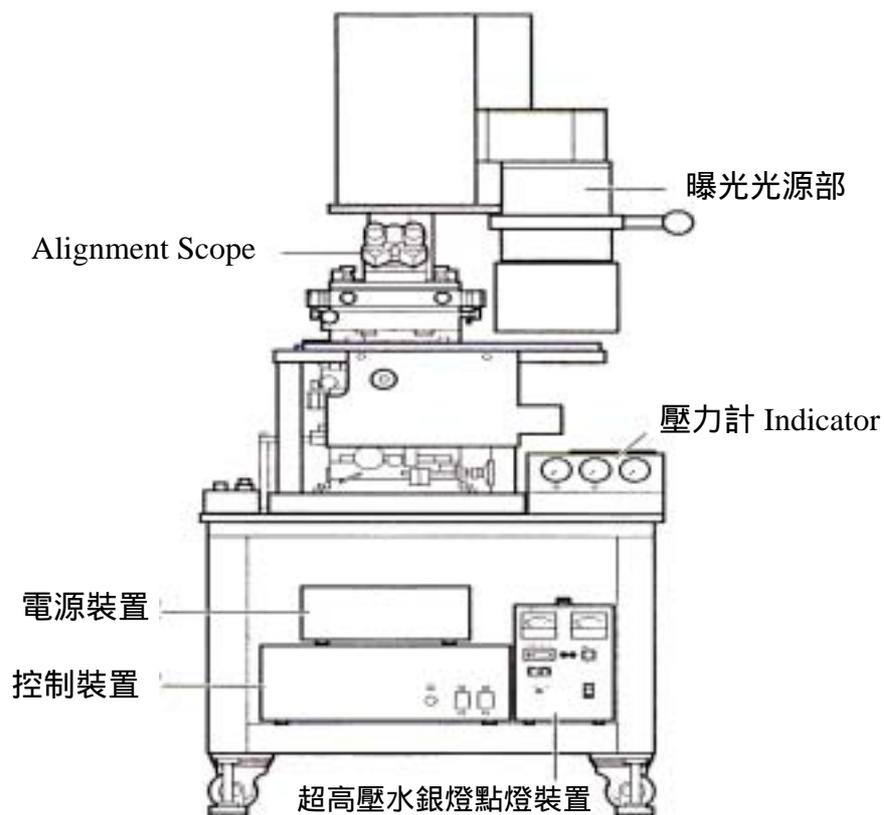


PEM-800 曝光機台操作手冊

1. 機台結構

1.1 機台本體





1.2 操作面板



1.3 抽真空機構



1.4 電源裝置



2. 操作前的確認

2.1 開啟氮氣閥門(橘色管路)



垂直為關
平行為開

2.2 開啟電源裝置

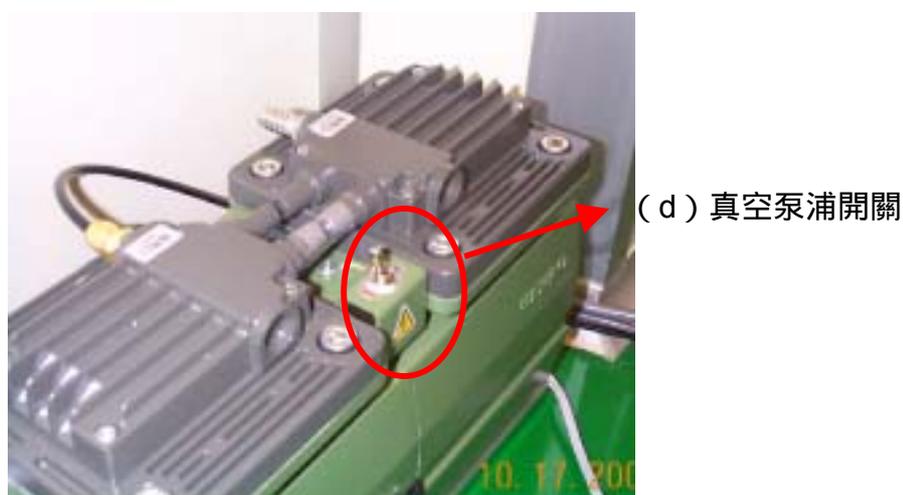


請依序開啟電源裝置

- (1) 先開啟 (a) 之電源開關
- (2) 再開啟 (b) 之控制開關
- (3) 最後開啟 (c) 之汞燈開關，先「POWER ON」再按「PUSH ON」，等待『STABLE』燈亮，此時穩定電流約 4-6A，穩定電壓約 30-45 之間。

* 注意：汞燈曝光前需暖機 20 分鐘，開關汞燈需間隔 1 小時以上。

2.3 開啟真空泵浦



2.4 檢查機台壓力表



- (1) 檢查「N2 壓力計」是否在 0.05 處
- (2) 檢查「壓力計」是否在 0.4 ~ 0.6 之間
- (3) 檢查「真空計」是否在 -80 ~ -100 之間

3. 操作步驟

3.1 先按綠色「RESET」，確認黃燈「DATA SET SW」是否亮起。



3.2 曝光參數設定

- (1) 按下操作面板最上面的 DATA SET SW (開關) 群的 [PRO] SW, 面板就會閃爍, 利用數字鍵 (0-9) 輸入 GAP 值, 再按下 [SET] SW 即完成設定。* 請依光阻的種類, 膜厚, 曝光時間等等的條件輸入適當值。



- (2) 將 PRINT GAP (曝光時光罩與晶圓間間距) 以「SET」SW 輸入設定完成之後，接下來 ALIGN GAP Digital Display 就會閃爍，請依前項的要領進行 ALIGN GAP (對準時光罩與晶圓間間距) 設定。
- (3) 將 ALIGN GAP 以「SET」SW 輸入設定完成之後，接下來 EXP.TIME (曝光時間) 的 Digital Display 就會閃爍，請依前項的要領進行 EXP.TIME 設定。

【基本上上述設定完成後即完成參數設定，接下來的參數設定跳過即可】

- (4) 前項設定完成之後，按下[SET]switch，表示動作模式的數字會閃爍，選擇想要的動作模式，完成 Program Mode 設定。

* 確認 Digital Display 是否在下列數值，請勿隨意更改。

1		1
2		1

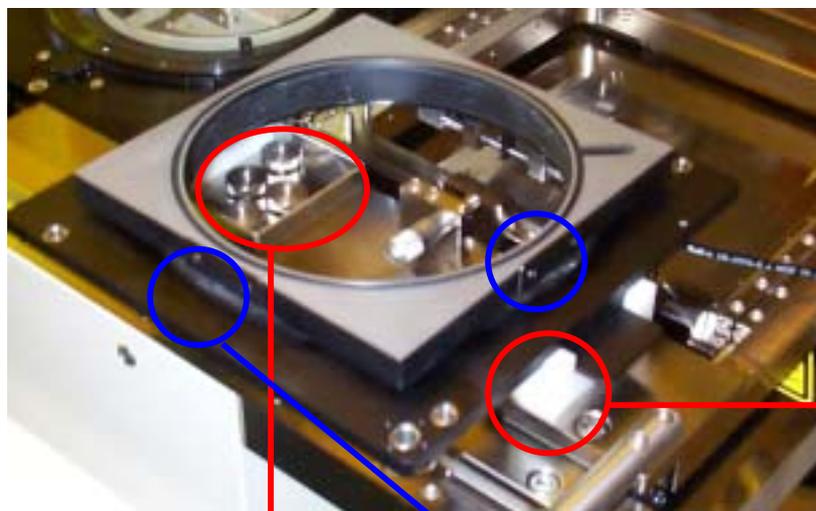
- (5) 以上初期設定完成之後，按下 [PRO] SW 之後，即完成曝光參數的設定。

* 請勿隨意按下圖紅框中的按鈕，此為機台校正維修時使用。



3.3 Mask Set 方法

- (1) 將 Mask Holder 的 Mask Set 面朝上放在 Mask Holder 設置台(位於 Mask Slider 的上面)



卸下螺絲放置處 定位夾具

光罩架設置台

- (2) 以 CDA 將光罩吹乾淨，Mask 的 Pattern 面朝上，將 Mask 放在 Mask Holder 的 Mask 吸著面。
- (3) 將 Mask 對準 2 個定位 Pin，做 Mask 定位。按下右側操作面板的 **MASK** SW，讓 Mask 真空吸著。(Mask 一真空吸著，則 **MASK** SW 點燈，**ADVANCE** SW 閃爍。)

- (4) 確認 Mask 真空吸著後,將 Mask Holder 翻轉,安裝到 Mask Slider。Mask Slider 上有 2 個定位 Pin 和 4 個固定用螺絲。



- (5) 將 Mask Holder 對準 Mask Slider 上的兩個定位 Pin,即完成 Mask Set。

4. 曝光步驟

- (1) 確定 **MASK** 為點燈 (狀態為持續亮著,不閃爍),而 Mask Holder 已固定在 Mask Slider 上。按下閃爍中的 **ADVANCE** SW,進行下一步。(此時 **WAFER**及 **ADVANCE** SW 閃爍)
- (2) 將 Wafer 放在 Wafer Chuck 上,並要完全覆蓋於真空吸著(Wafer Chuck 上有許多小孔,晶圓要完全覆蓋住小孔才可以進行下一個步驟)。
- (3) Wafer Chuck 上刻有各種尺寸用的圓線,請將 Wafer 置於切好邊的定位圓內。



- (4) 按下閃爍中的 **WAFER** SW，將 Wafer 吸著固定。(請務必確認 Wafer 真空吸著，若正確的吸著固定時會亮燈，反之會由亮燈轉變為點散閃爍燈狀態。)接著按下閃爍中的 **ADVANCE** SW 進行下一步。
- (5) 手動操作慢慢將 Mask Slider 由右側推至左側。



- (6) 頂住吸著 Stopper(有一個接觸軟墊)，按下閃爍中的 **MASK H1** SW，將 Mask Slider 吸著固定。(**MASK H1** SW 轉變為點燈，**ADVANCE** SW 閃爍。)



- (7) 按下 **ADVANCE** SW。(Z 軸會自動上昇至設定的 Alignment Gap 位置。**ALIGN**SW 點燈。)此動作務必確實做到，避免不是在非 **Alignment Gap** 位置下進行對準，則會造成找不到確實的影像。
- (8) 接著，用手動操作將顯微鏡移至 Mask 中央，直到顯微鏡 Click 為止。請用顯微鏡觀察，進行 Mask 和 Wafer 的對位。



- (9) 開啟光圈電源右旋到三分之二處如下圖

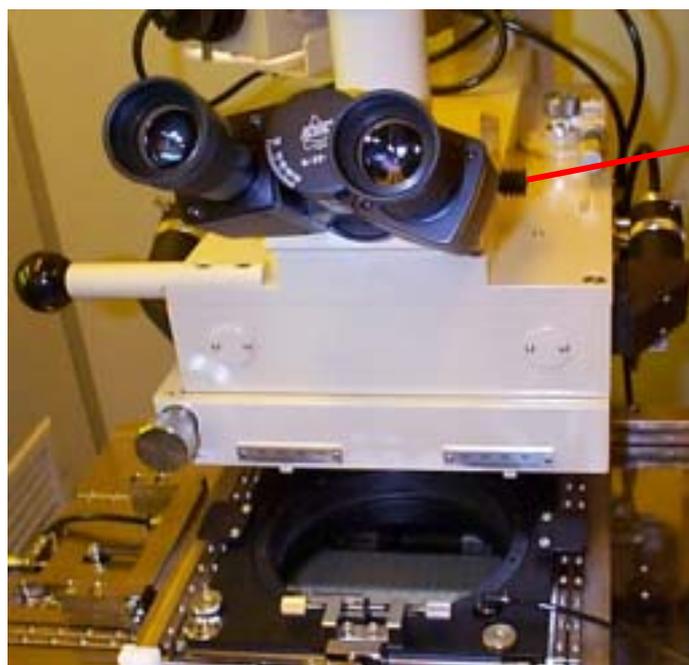




旋至「MASK」處

(10) 轉換顯像至 CCD 螢幕

(a) 拉起影像切換桿，將影像傳至 CCD 銀幕(如下圖)。



影像
切換
桿

(b) 開啟螢幕電源



電源開關

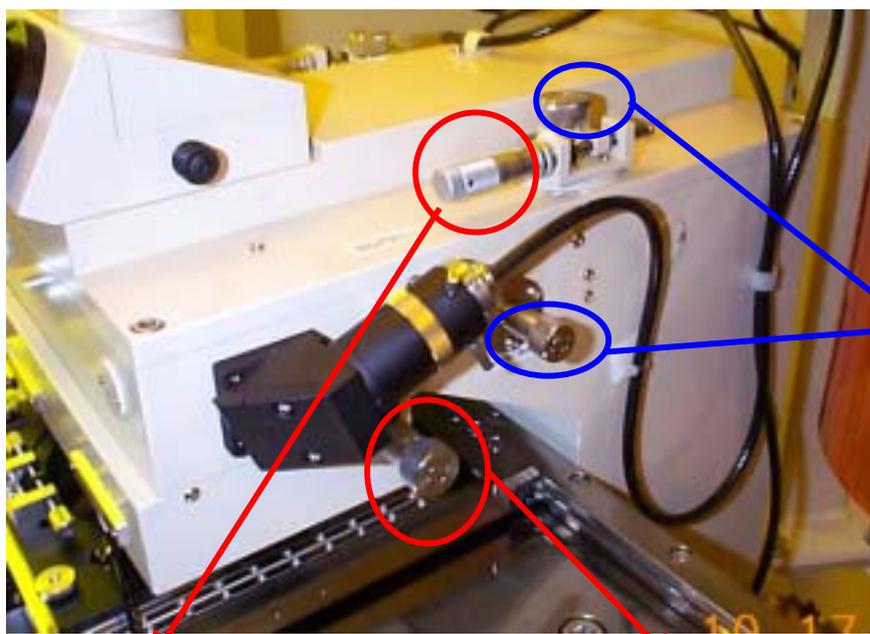


螢幕電源

(11) 調整目鏡座標軸，直到找到 KEY 的位置

* 注意目鏡左眼看到為右邊目標，需調整右邊的目鏡位置

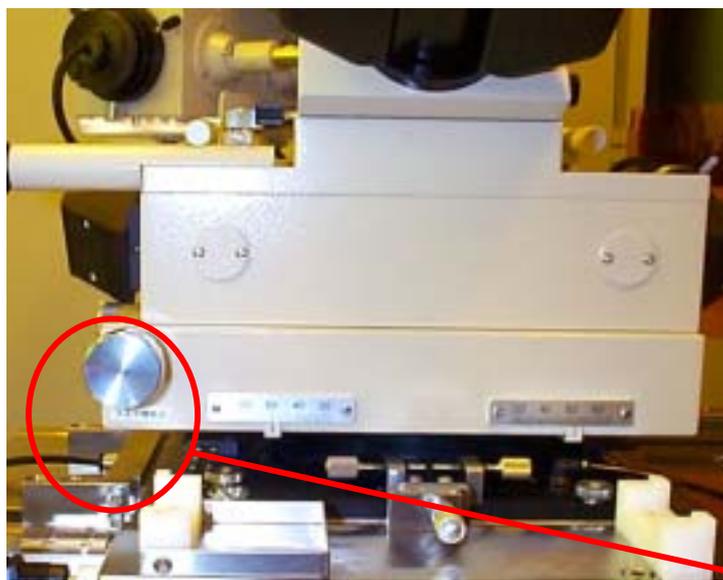
目鏡調整 X、Y 軸旋鈕，位置如下



注意：這兩個旋鈕不要動

目鏡左邊 Y 軸移動鈕

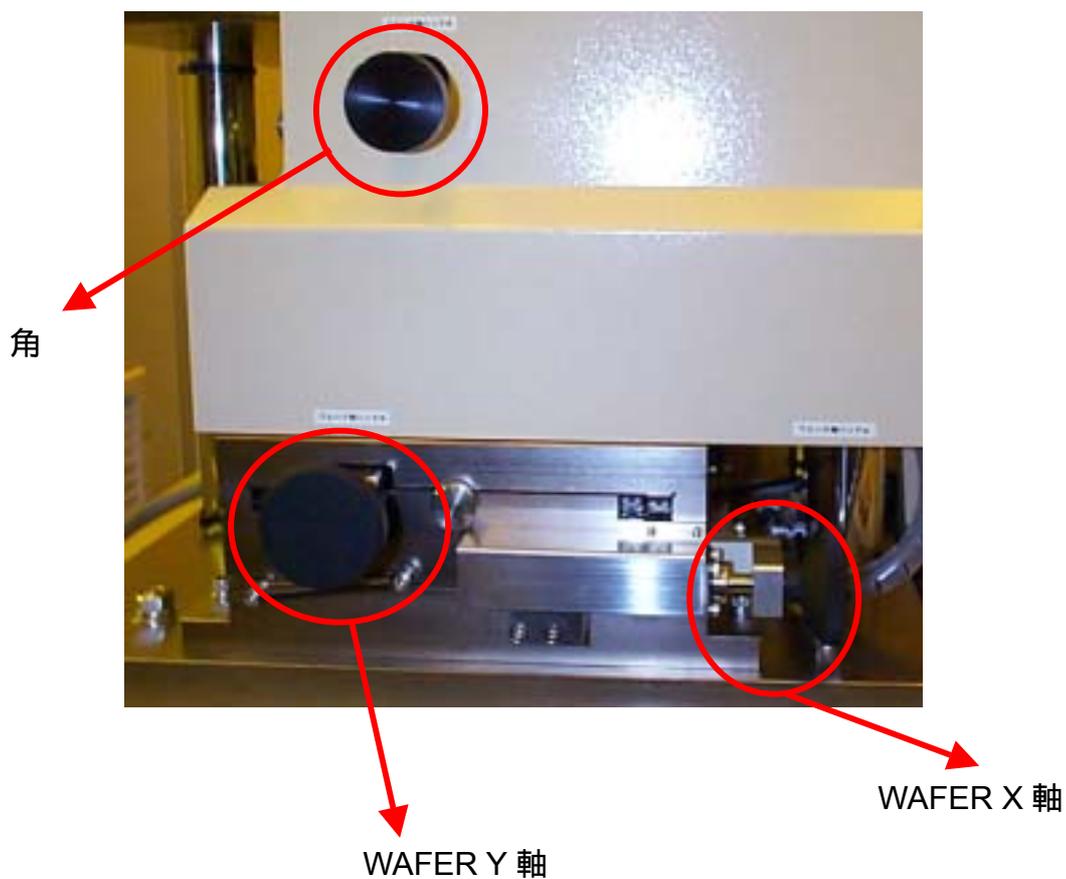
目鏡左邊 X 軸移動鈕



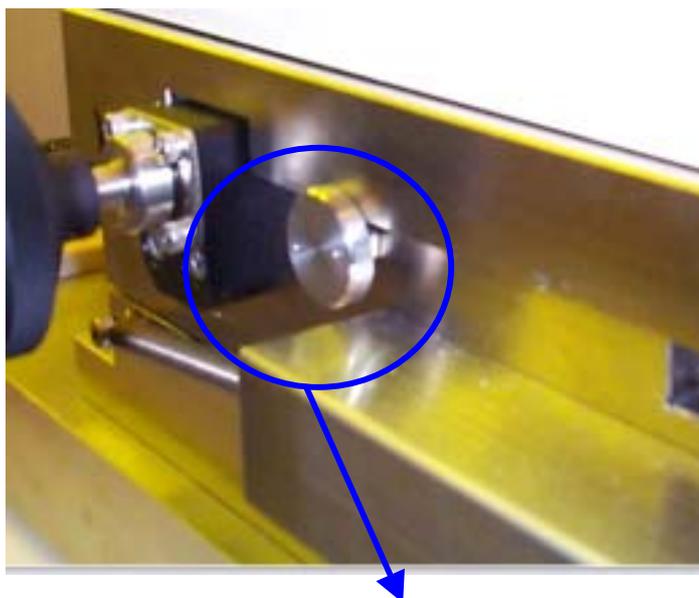
焦距調整鈕



(12) 手動調整 Wafer Stage 的 X.Y.θ 作 Alignment，直到與 MASK 的 PATTERN 對準，各軸旋鈕位置如下圖。



* 注意，旋轉時，若感覺已經無法再旋轉，請勿再用力旋動，以免損壞機台



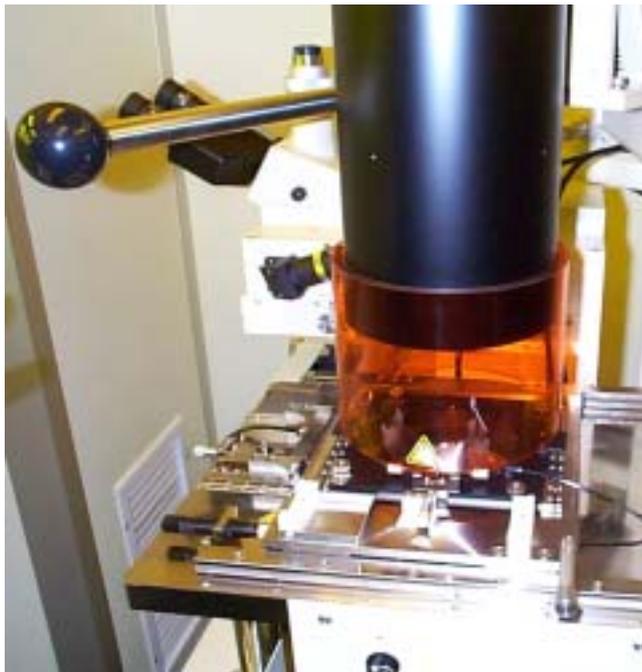
此已經到底，勿再旋動，注意此類似地方有四處

(13) Alignment 完成之後，按下 **CONTACT** SW。(**CONTACT** SW 轉變為點燈、**ADVANCE** SW 閃爍)

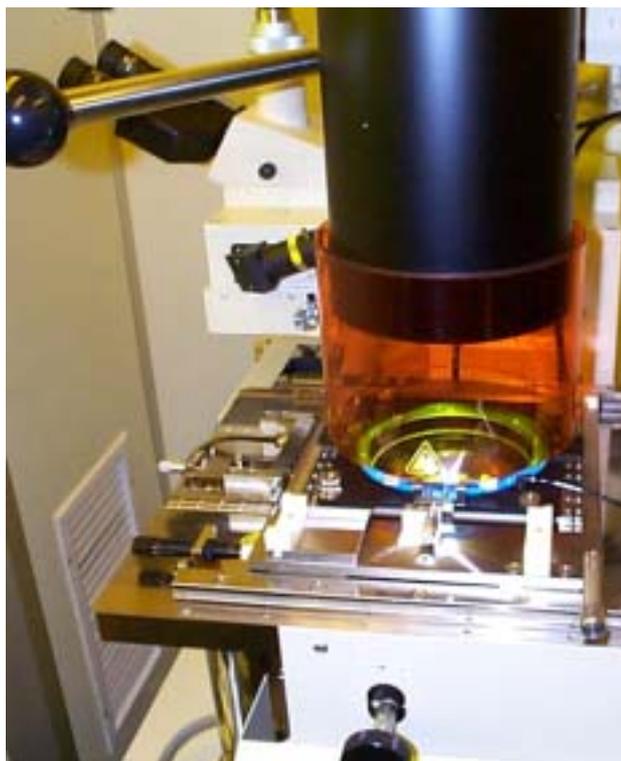
(14) Wafer Stage 上昇至 Contact 位置。調整顯微鏡的焦點，曝光前作 Alignment 的狀態確認。(按 **ALIGN** SW，Z 軸下降至 Alignment Gap 位置，可再進行 Alignment。)

* 注意，在 CONTACT 時不得移動 wafer 或 mask 平台，否則將損壞光罩。
選擇 [N2 BLOW] SW ON 或 OFF。(一般為 OFF)

(15) 對位完成後，以手動方式將顯微鏡移到後面，旋轉曝光 Box。將曝光 Box 慢慢旋轉至 Mask 正上方的曝光位置，直到其 Click 固定住。



(16) 按下 **ADVANCE** SW，即按照所設定的秒數進行曝光。



(17) 曝光完畢後，Wafer Stage 自動下降至原點位置。(Mask Slider 吸著 OFF、Wafer 吸著 OFF、**WAFER**SW 及 **ADVANCE**SW 閃爍。)

(18) 將曝光 Box 旋轉至原位置。



- (19) 將 Mask Slider 手動向右推至待機位置。
- (20) 取出 Wafer 後，按「RESET」，此時「MASK」依然吸真空，卸下螺絲，取出 MASK 放於支架上。
- (21) 按「MASK」讓光罩不吸真空，取出光罩。
- (22) 將光罩放回 MASK HOLDER。
- (23) 完成。

5. 關機步驟

- (1) 關閉真空泵浦電源
- (2) 關閉汞燈開關，先關汞燈啟動開關（按一下藍色區域的開關），再關汞燈電源開關（紅色區域的開關）。



* 注意：下一次再開啟汞燈需間隔 1 小時以上。

- (3) 關閉曝光機控制開關，先關藍色區域的開關（左），再關紅色區域的開關（右）。



(4) 關閉變壓器電源。



(5) 填寫使用紀錄簿